

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2021/134972 A1

(43) 国际公布日
2021 年 7 月 8 日 (08.07.2021)

(51) 国际专利分类号:
C23C 14/34 (2006.01) *B22F 3/15* (2006.01)
B22F 3/093 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2020/084101

(22) 国际申请日: 2020 年 4 月 10 日 (10.04.2020)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202010002184.0 2020 年 1 月 2 日 (02.01.2020) CN

(71) 申请人: 宁波江丰电子材料股份有限公司
(KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL CO.,
LTD) [CN/CN]; 中国浙江省余姚市名邦科技工业
园区安山路198号, Zhejiang 315400 (CN)。

(72) 发明人: 姚力军(YAO, Lijun); 中国浙江省余姚
市名邦科技工业园区安山路 198 号, Zhejiang
315400 (CN)。 潘杰(PAN, Jie); 中国浙江省余
姚市名邦科技工业园区安山路 198 号, Zhejiang
315400 (CN)。 边逸军(BIAN, Yijun); 中国浙江
省余姚市名邦科技工业园区安山路 198 号,

Zhejiang 315400 (CN)。 王学泽(WANG, Xueze);
中国浙江省余姚市名邦科技工业园区安山
路 198 号, Zhejiang 315400 (CN)。 马国成(MA,
Guocheng); 中国浙江省余姚市名邦科技工业园
区安山路198号, Zhejiang 315400 (CN)。

(74) 代理人: 北京品源专利代理有限公司(BEYOND
ATTORNEYS AT LAW); 中国北京市海淀区莲花
池东路39号西金大厦6层, Beijing 100036 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS,
JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(54) Title: CHROMIUM-SILICON ALLOY SPUTTERING TARGET MATERIAL AND PREPARATION METHOD THEREFOR

(54) 发明名称: 一种铬硅合金溅射靶材及其制备方法

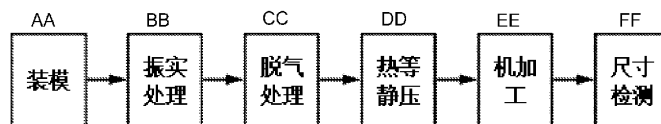


图 1

AA Packing a mold
BB Jolt ramming
CC Degassing
DD Heated isostatic pressing
EE Machining
FF Size check

(57) Abstract: The present application relates to a chromium-silicon alloy sputtering target material and a preparation method therefor. The preparation method comprises: (1) packing chromium-silicon alloy powder having a target mass ratio into a mold, sealing same, and performing jolt ramming; (2) degassing the mold which was jolt rammed in step (1); (3) performing heated isostatic pressing on the mold degassed in step (2) at 1000-1350°C, and obtaining a crude chromium-silicon alloy sputtering target material; and (4) obtaining a chromium-silicon alloy sputtering target material after machining.

(57) 摘要: 本申请涉及一种铬硅合金溅射靶材及其制备方法。所述制备方法包括: (1)将具有目标质量比例的铬硅合金粉末装入模具并封口, 进行振实处理; (2)将步骤(1)振实后的模具进行脱气处理; (3)将步骤(2)脱气后的模具在1000-1350°C下进行热等静压处理, 得到铬硅合金溅射靶材粗品; (4)机加工后得到铬硅合金溅射靶材。

[见续页]

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。